

Содержание

● XVIII Международная Конференция
Термоэлектрики и их применения — 2023
(ISCTA-2023), Санкт-Петербург, 11–14 сентября 2023

Юрьев В.А., Чуйко А.Г., Калинин Ю.Е., Гребенников А.А., Каширин М.А.
Влияние термической обработки на термоэлектрические и механические свойства твердого раствора $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ р-типа проводимости, полученного методом экструзии . . . 63

Щербакова К.А., Чернышова Е.В., Аргунов Е.В., Бочканов Ф.Ю., Воронин А.И., Ховайло В.В.
Зависимость термоэлектрических свойств $\text{CeFe}_{3.5}\text{Co}_{0.5}\text{Sb}_{12}$ от параметров механохимического синтеза и искрового плазменного спекания 68

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Шуман В.Б., Астров Ю.А., Лодыгин А.Н., Порцель Л.М.
Взаимодействие Mg с кислородом и углеродом в кремнии 75

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Орлов Л.К., Зедоми Т.Э., Ивина А.С., Орлов М.Л.
Высокочастотные свойства двумерной квантовой сверхрешетки в сильном однородном электрическом поле 78

Быков А.А., Номоконов Д.В., Стрыгин И.С., Марчишин И.В., Родякина Е.Е.
Соизмеримые осцилляции и положительное магнетосопротивление в двухподзонной квазидвумерной электронной системе с периодической латеральной модуляцией 89

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Калмыков А.Е., Сорокин Л.М., Курдюков Д.А.
Структурное состояние InSb в композитном материале InSb/опал по данным просвечивающей электронной микроскопии 93

● Физика полупроводниковых приборов

Гаврина П.С., Подоскин А.А., Шушканов И.В., Шашкин И.С., Крючков В.А., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симмаков В.А.
Влияние длины резонатора на выходную оптическую мощность полупроводниковых лазеров-тиристоров на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs/InGaAs 96

Wang Z.X., Liu M.Q., Wang T.B., Li M., Tang G.H., Aierken A., Zhong L.
Evaluation of electrical parameters of electron and proton irradiated GaInP/GaAs/InGaAs metamorphic solar cells . . . 106

Фоминых Н.А., Крыжановская Н.В., Комаров С.Д., Махов И.С., Иванов К.А., Моисеев Э.И., Антонов Е.Е., Гусева Ю.А., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Хабибуллин Р.А., Галиев Р.Р., Павлов А.Ю., Томош К.Н., Жуков А.Е.
Микродисковые лазеры на основе InGaAs/GaAs-квантовых точек, монолитно-интегрированные с волноводом 107